



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2014-0135184
(43) 공개일자 2014년11월25일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01L 27/146 (2006.01) H01L 27/14 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2014-7025054
(22) 출원일자(국제) 2013년02월05일
심사청구일자 없음
(85) 번역문제출일자 2014년09월05일
(86) 국제출원번호 PCT/US2013/024684
(87) 국제공개번호 WO 2013/119513
국제공개일자 2013년08월15일
(30) 우선권주장
13/425,877 2012년03월21일 미국(US)
61/596,694 2012년02월08일 미국(US)

(71) 출원인
지티에이티 코퍼레이션
미국 뉴햄프셔 03054 메리맥 테니얼 웹스터 하이웨이 243
(72) 발명자
머칼리, 벤카테산
미국 95120 캘리포니아 새너제이 퀸즈브릿지 웨이 1102
차리, 아르빈드
미국 95070 캘리포니아 사라토가 집시 힐 로드 14801
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
김미희, 이시용, 정현주

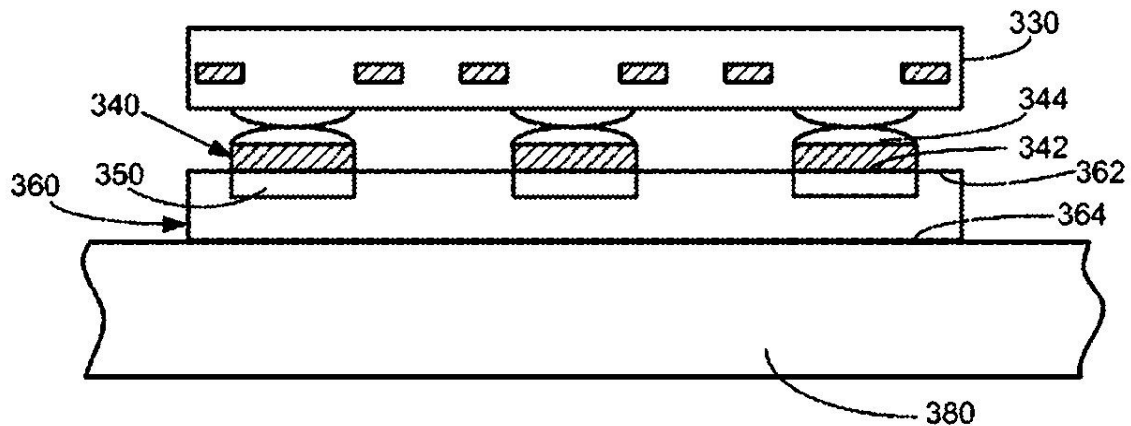
전체 청구항 수 : 총 22 항

(54) 발명의 명칭 배면측-조명 센서들을 제조하기 위한 방법

(57) 요약

배면측-조명 센서를 제조하기 위한 방법은 제 1 전도성을 갖는 박막 반도체 박판을 제공하는 것 및 박판의 전면 표면에 그리고 박판 내에 제 2 전도성을 갖는 도핑된 영역을 형성하는 것을 포함한다. 박판은 프리-스탠딩 박판으로서 제공될 수 있거나 박판이 클리빙되는 반도체 도너 바디로서 제공될 수 있다. 전기적 연결은 도핑된 영역에 대해 형성된다. 임시 캐리어가 반도체의 배면 표면에 접촉되고 추후 제거된다. 배면측-조명 센서는 반도체 박판의 두께가 실질적으로 제조 프로세스 동안 변경되지 않은 채로 유지되는 반도체 박판으로부터 제조된다.

대표도 - 도3c



(72) 발명자

프라부, 고탈

미국 95136 캘리포니아 새너제이 퀴리 파크 드라이브 3500

페티, 크리스토퍼 제이.

미국 94041 캘리포니아 마운틴 뷰 세라 애비뉴 660

특허청구의 범위

청구항 1

배면측-조명 센서를 제조하는 방법으로서,

전면 표면, 배면 표면 및 상기 전면 표면과 상기 배면 표면 간의 두께를 갖는 박막 반도체 박판(thin film semiconductor lamina)을 제공하는 단계 - 상기 반도체 박판은 제 1 전도성을 가짐 - ;

상기 박판의 전면 표면에서 상기 반도체 박판 내에 도핑된 영역을 형성하는 단계 - 상기 도핑된 영역은 제 2 전도성을 가짐 -;

상기 반도체 박판의 배면 표면에 임시 캐리어를 접촉시키는 단계;

상기 반도체 박판의 전면측에 상기 도핑된 영역에 대한 전기적 연결을 형성하는 단계;

상기 배면 표면으로부터 상기 임시 캐리어를 제거하는 단계; 및

상기 반도체 박판으로부터 배면측-조명 센서를 제조하는 단계

를 포함하고,

상기 반도체 박판의 두께는 상기 배면측 조명 센서의 제조 동안 실질적으로 변경되지 않은 채로 유지되는,

배면측-조명 센서를 제조하는 방법.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

제 1 표면을 갖는 반도체 도너 바디(semiconductor donor body)를 제공하는 단계 - 상기 반도체 도너 바디는 제 1 전도성을 가짐 - ;

클리브 플레인(cleave plane)을 정의하도록 상기 반도체 도너 바디의 제 1 표면에 이온들을 주입하는 단계;

상기 클리브 플레인에서 상기 반도체 도너 바디를 클리빙(cleaving)하는 단계

를 더 포함하고,

상기 클리브 플레인 은 상기 반도체 박판의 배면 표면을 형성하고,

상기 반도체 도너 바디의 제 1 표면은 상기 반도체 박판의 전면 표면을 형성하는,

배면측-조명 센서를 제조하는 방법.

청구항 3

제 2 항에 있어서,

상기 이온들을 주입하는 단계, 상기 반도체 도너 바디를 클리빙하는 단계, 및 상기 도핑 영역을 형성하는 단계 들만이 약 450℃ 초과 의 프로세싱 온도들을 갖는,

배면측-조명 센서를 제조하는 방법.

청구항 4

제 2 항에 있어서,

상기 도핑된 영역을 형성하는 단계는,

상기 이온들을 주입하는 단계 이전에 발생하는,

배면측-조명 센서를 제조하는 방법.

청구항 5

제 2 항에 있어서,
 상기 이온들을 주입하는 단계는,
 주입 에너지를 포함하고,
 상기 주입 에너지는 상기 클리브 플래인의 깊이를 결정하며, 상기 깊이는 상기 반도체 도너 바디의 제 1 표면으로부터 측정되고,
 상기 깊이는 상기 반도체 박판의 두께와 실질적으로 등가가 되도록 선택되는,
 배면측-조명 센서를 제조하는 방법.

청구항 6

제 1 항에 있어서,
 상기 전기적 연결을 형성하는 단계는,
 상기 반도체 박판의 전면측에 금속화층을 도포(apply)하는 단계; 및
 집적 회로를 상기 금속화층에 커플링하는 단계를 포함하는,
 배면측-조명 센서를 제조하는 방법.

청구항 7

제 6 항에 있어서,
 상기 집적 회로는,
 CMOS(complementary metal-oxide semiconductor)인,
 배면측-조명 센서를 제조하는 방법.

청구항 8

제 1 항에 있어서,
 상기 반도체 박판의 배면 표면에 컬러 필터를 커플링하는 단계를 더 포함하는,
 배면측-조명 센서를 제조하는 방법.

청구항 9

제 1 항에 있어서,
 상기 박막 반도체 박판의 두께는 약 25 미크론 미만인,
 배면측-조명 센서를 제조하는 방법.

청구항 10

제 1 항에 있어서,
 상기 박막 반도체 박판의 두께는 약 1 내지 약 50 미크론인,
 배면측-조명 센서를 제조하는 방법.

청구항 11

제 1 항에 있어서,
 상기 반도체 박판의 두께는,
 상기 배면측-조명 센서의 제조 동안 그의 초기에 제공된 두께의 20% 편차 내에서 유지되는,

배면측-조명 센서를 제조하는 방법.

청구항 12

배면측-조명 센서를 제조하는 방법으로서,

제 1 표면 및 제 1 전도성을 갖는 반도체 도너 바디를 제공하는 단계;

상기 제 1 표면에서 상기 반도체 도너 바디 내에 도핑된 영역을 형성하는 단계 - 상기 도핑된 영역은 제 2 전도성을 가짐 - ;

클리브 플레인(cleave plane)을 정의하도록 상기 반도체 도너 바디의 제 1 표면으로 이온들을 주입하는 단계;

상기 클리브 플레인에서 상기 반도체 도너 바디로부터 반도체 박판을 클리빙하는 단계 - 상기 클리브 플레인온 상기 반도체 박판의 배면 표면을 형성하고, 상기 반도체 도너 바디의 제 1 표면은 상기 반도체 박판의 전면 표면이고, 상기 전면 표면은 상기 도핑된 영역을 포함함 -;

상기 반도체 박판의 배면 표면에 임시 캐리어를 접촉시키는 단계;

상기 반도체 박판의 전면측 상의 상기 도핑된 영역에 대한 전기적 연결을 형성하는 단계;

상기 배면 표면으로부터 상기 임시 캐리어를 제거하는 단계; 및

상기 반도체 박판으로부터 배면측-조명 센서를 제조하는 단계

를 포함하고,

상기 반도체 박판의 전면측과 배면 표면 간의 두께는 상기 배면측-조명 센서의 제조 동안 실질적으로 변경되지 않은 채로 유지되는,

배면측-조명 센서를 제조하는 방법.

청구항 13

제 12 항에 있어서,

상기 전기적 연결을 형성하는 단계는,

상기 반도체 박판의 전면측에 금속화층을 도포하는 단계; 및

상기 금속화층에 집적 회로를 커플링하는 단계를 포함하는,

배면측-조명 센서를 제조하는 방법.

청구항 14

제 12 항에 있어서,

상기 반도체 박판의 배면 표면에 컬러 필터를 커플링하는 단계

를 더 포함하는,

배면측-조명 센서를 제조하는 방법.

청구항 15

제 12 항에 있어서,

상기 도핑된 영역들을 형성하는 단계는,

이온들을 주입하는 단계 이전에 발생하는,

배면측-조명 센서를 제조하는 방법.

청구항 16

제 12 항에 있어서,

상기 박막 반도체 박판의 두께는 약 1 미크론 내지 약 50 미크론인,
배면측-조명 센서를 제조하는 방법.

청구항 17

제 12 항에 있어서,

상기 반도체 박판의 두께는 상기 배면측-조명 센서의 제조 동안 그의 초기에 제공되는 두께의 20% 편차 이내에서 유지되는,

배면측-조명 센서를 제조하는 방법.

청구항 18

제 12 항에 있어서,

상기 이온들을 주입하는 단계는 주입 에너지를 포함하고,

상기 주입 에너지는 상기 클리브 플래인의 깊이를 결정하고, 상기 깊이는 상기 반도체 도너 바디의 제 1 표면으로부터 측정되는,

배면측-조명 센서를 제조하는 방법.

청구항 19

제 12 항에 있어서,

클리빙된 반도체 박판의 두께는 제조된 배면측-조명 센서의 반도체 기관의 원하는 최종 두께와 실질적으로 등가인,

배면측-조명 센서를 제조하는 방법.

청구항 20

제 12 항에 있어서,

상기 도핑된 영역들을 형성하는 단계, 이온들을 주입하는 단계 및 상기 반도체 도너 바디를 클리빙하는 단계들만이 약 450℃ 초과와 프로세싱 온도들을 갖는,

배면측-조명 센서를 제조하는 방법.

청구항 21

제 12 항에 있어서,

상기 박판으로부터 배면측-조명 센서를 제조하는 단계는,

상기 박판의 배면 표면을 패시베이팅하기 위한 층을 증착하는 단계를 포함하는,

배면측-조명 센서를 제조하는 방법.

청구항 22

제 21 항에 있어서,

상기 패시베이팅 층은,

수소화된 비정질 실리콘을 포함하는,

배면측-조명 센서를 제조하는 방법.

명세서

기술분야

[0001] 관련 출원들

[0002] [001] 본 출원은 2012년 3월 21일 출원되고 발명의 명칭이 "Method for Fabricating Backside-Illuminated Sensors"인 미국 출원 번호 제13/425,877호를 우선권으로 주장하고; 2012년 2월 8일 출원되고 발명의 명칭이 "Method for Fabricating Backside-Illuminated Sensors"인 미국 가출원 번호 제61/596,694호를 우선권으로 주장하며, 그에 의해 이들 두 출원들은 모든 목적을 위해 인용에 의해 포함된다. 본 출원은 2012년 3월 21일 출원되고 발명의 명칭이 "Back-Contact Photovoltaic Cell Comprising A Thin Lamina Having A Superstate Receiver Element"인 미국 특허 출원 번호 제13/425,870호에 또한 관련되며, 그에 의해 상기 출원은 모든 목적들을 위해 인용에 의해 포함된다.

배경 기술

[0003] [002] 이미지 센서들은 광을 수신하고, 수신된 광의 양에 기초하여 에너지를 전기 신호들로 변환한다. 이미지 센서들은 일반적으로 전기 신호들을 프로세싱하기 위해 통합된 칩과 같은 전기 회로 및 실리콘 광-감지 층을 포함한다. 분해능(resolution)을 개선하기 위해 칩 상에 픽셀 밀도를 증가시키는 것이 바람직하다. 그러나 픽셀 밀도를 증가시키는 것은 크로스토크 및 더 밀집된 회로 배선과 같은 이슈들을 생성한다.

[0004] [003] 전면측-조명(FSI) 센서들에서, 광은 금속 상호연결들이 놓이는 칩의 "전면(front)"에 진입한다. 배선의 양의 증가는 보다 많은 섀도우잉(shadowing) 및 이에 따른 실리콘 광-감지 층에 도달하는 광의 더 적은 효율을 야기한다. 배면측-조명(BSI) 센서들에서, 광은 칩의 실리콘 측에 진입하고, 그에 따라 금속 상호연결 층들의 관통을 요구하지 않는다. 따라서, BSI 센서들은 진보된 이미지 센싱 기술에 대해 바람직하다. 그러나 BSI 센서들은 광이 관통하여 광활성 층에 도달하기 위해 더 얇은 실리콘을 요구하며, 그에 따라 FSI 센서들만큼 제조하는데 있어 비용-효율적인 것은 아니다. BSI 센서들은 또한 칩에 걸친 두께의 정밀한 균일도를 요구하는데, 이는 달성하기 어려울 수 있다.

[0005] [004] 얇은 반도체 웨이퍼들을 제조하기 위한 하나의 접근법은 실리콘의 층들이 벌크 실리콘 기판 상에서 성장되는 에피택셜 실리콘을 활용한다. 실리콘 기판은 통상적으로 1.5 미크론 미만의 매우 얇은 시트이다. 다른 접근법은 더 두꺼운 실리콘 웨이퍼를 이용하고 회로 및 상호연결 층들이 형성된 이후 이를 원하는 두께로 그린딩(grinding)한다. 그린딩을 이용하여 두께 면에서 필수적인 정밀한 균일도를 달성하는 것이 어렵기 때문에 BSI 프로세싱은 종종 웨이퍼 레벨 그린딩 및 다이 레벨 폴리싱 둘 다를 요구한다. 이는 쓰루풋 이슈들을 생성하고, 비용을 증가시키며 오염을 야기할 수 있다. BSI 센서들을 제조하는데 있어서의 다른 팩터들은, 물질들 및 제조 단계들의 시퀀스, 및 제조 동안 박막들을 핸들링하는 능력에 크게 영향을 주는, 다양한 제조 스테이지들에서의 프로세싱 온도의 차이를 포함한다.

발명의 내용

[0006] [005] 배면측-조명 센서를 제조하기 위한 방법은 제 1 전도성을 갖는 박막 반도체 박판을 제공하는 것 및 박판의 전면 표면에 그리고 박판 내에 제 2 전도성을 갖는 도핑된 영역을 형성하는 것을 포함한다. 도핑된 영역에 대한 전기적 연결이 형성된다. 임시 캐리어가 반도체의 배면 표면에 접촉되고 추후 제거된다. 배면측-조명 센서는 제공된 반도체 박판의 두께가 제조 프로세스 동안 실질적으로 변경되지 않은 채로 유지되는 반도체 박판으로부터 제조된다.

[0007] [006] 다른 실시예들에서, 배면측-조명 센서를 제조하기 위한 방법은 제 1 전도성을 갖는 반도체 도너 바디를 제공하는 단계를 포함한다. 제 2 전도성의 도핑된 영역은 도너 바디 내에 그리고 도너 바디의 제 1 표면에 형성된다. 이온들이 클리브 플레인들 정의를 위해 제 1 표면에 주입되고, 반도체 박판이 도너 바디로부터 클리빙된다. 도핑된 영역이 박판에 포함되고, 도핑된 영역에 대한 전기적 연결이 형성된다. 임시 캐리어가 반도체의 배면 표면에 접촉되고 추후 제거된다. 배면측-조명 센서는 제공된 반도체 박판의 두께가 제조 동안 실질적으로 변경되지 않은 채로 유지되는 반도체 박판으로부터 제조된다.

[0008] [007] 본 명세서에서 설명되는 본 발명의 양상들 및 실시예들 각각은 단독으로 또는 다른 것과 결합하여 이용될 수 있다. 양상들 및 실시예들은 첨부된 도면들을 참조하여 이제 설명될 것이다.

도면의 간단한 설명

[0009]

도 1은 종래의 전면측-조명 센서의 단면도를 도시한다.

도 2는 종래의 배면측-조명 센서의 단면도를 도시한다.

도 3a 내지 도 3c는 다양한 제조 스테이지들에서, 배면측-조명 센서의 실시예의 단면도들이다.

도 4는 본 발명의 예시적인 방법의 흐름도이다.

도 5a 내지 도 5c는 다양한 제조 스테이지들에서 배면측-조명 센서의 다른 실시예의 예시적인 단면도들을 도시한다.

도 6은 본 발명의 다른 예시적인 방법의 흐름도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0010]

[0014] 배면측-조명 센서는 마무리된 센서 디바이스에 대한 원하는 두께와 실질적으로 등가의 두께를 갖는 박판(lamina)을 이용하여 제조된다. 몇몇 실시예들에서, 박판은 도핑된 영역들이 박판의 전면 표면에 그리고 그 내에 형성되는 프리-스탠딩(free-standing) 박판으로서 제공될 수 있다. 다른 실시예들에서, 도핑된 영역들은 반도체 도너 바디의 제 1 표면에 형성되고, 박판은 도너 바디로부터 클리빙(cleaved)되며, 여기서 도핑된 영역들은 박판의 전면 표면에 그리고 그 내부에 있다. 본 명세서에서 개시되는 방법들은 쓰루풋을 개선하고 제조 비용을 감소시키는 것을 가능케 한다.

[0011]

[0015] 도 1은 렌즈들(110), 컬러 필터(120), 집적 회로(130), 금속 상호연결 층(140), 도핑된 영역(150) 및 반도체 기관(160)을 포함하는 종래의 FSI 센서(100)의 단순화된 도면을 도시한다. 반도체 기관(160)은 제 1 전도성을 가지며 예를 들어, 실리콘일 수 있다. 도핑된 영역들(150)은 반도체 기관(160)과 상이한 전도성으로 도핑된다. 예를 들어, 반도체 기관(160)은 p-타입 전도체일 수 있는 반면에, 도핑된 영역들은 n-타입일 수 있다. 고갈 지역은 p-n 접합에 형성되어 전계를 생성한다. 도핑된 영역들(150) 및 반도체 기관(160) 간의 p-n 접합은 광다이오드를 형성한다. 화살표들(170)에 의해 표시되는 입사 광자들은 전자들이 원자가 대역으로부터 전도 대역이 되게 하여, 자유 전자-홀 쌍들을 생성할 것이다. p-n 접합의 전계 내에서, 전자들은 다이오드의 n 영역 쪽으로 이동하는 경향이 있는 반면에, 홀들은 p 영역 쪽으로 이동하여 결과적으로 광전류라 불리는 전류를 발생시킨다. 통상적으로, 하나의 영역의 도펀트 농도는 다른 영역의 도펀트 농도보다 높을 것이어서, 접합은 n-/p+ 접합 또는 p-/n+ 접합 중 어느 하나가 될 것이다.

[0012]

[0016] 도 1의 FSI 센서(100)에서, 금속 상호연결 층(140)은 배선 또는 상호연결들(142) 및 유전체(144)를 포함할 수 있다. 유사하게, 집적 회로(130)는 또한 배선(132)을 포함한다. 광(170)은 FSI 센서(100)의 "전면측"에 진입하며, 여기서 몇몇 광선들이 배선(132) 및 배선(142)에 의해 차단되거나 반사된다, 도핑된 영역들(150)에 도달하는 광 에너지는 이어서 집적 회로(130)에 의해 프로세싱되는 전기 신호들로 변환된다.

[0013]

[0017] 도 2는 종래의 BSI 센서(200)의 단순화된 도면이다. BSI 센서는 본질적으로 인버팅된 FSI이어서, 광은 반도체 기관을 통해 배면측에 진입한다. 도 2에서, 화살표(270)에 의해 표시되는 입사광은 렌즈(210)에 진입하고, 컬러 필터(220)를 관통하고 이어서 반도체 기관(260)을 통해 다이오드 영역(250)으로 진행하여, 금속 상호연결 층(240) 및 집적 회로(230)의 배선에 의해 방해받지 않는다. 따라서, 광자들을 캡처하는 효율이 FSI 센서들에 비해 BSI 센서들의 경우 크게 증가된다. 그러나 광이 도핑된 영역들(250)에 도달하도록 허용하기에 충분히 얇은 반도체 기관(260)을 제조하는 것은, 기관(260)이 또한 두께 면에서 높은 정밀한 균일도 및 프로세싱 동안 박막 반도체에 대한 손상의 방지를 요구하기 때문에 매우 어렵게 될 수 있다. 그린딩은 통상적으로 실리콘 웨이퍼를 박화(thin)하는데 이용되지만, 웨이퍼 레벨 그린딩은 공통적으로 웨이퍼에 걸친 두께의 변동을 초래한다. 그러므로 부가적인 다이 레벨 폴리싱이 종종 수행된다. 다수의 물질 제거 단계들에 대한 요구는 더 낮은 쓰루풋, 더 높은 비용, 표면 오염의 증가된 위험 및 증가된 핸들링으로 인한 반도체 기관에 대한 손상의 가능성과 같은 다양한 이슈들을 생성한다.

[0014]

[0018] 도 3a 내지 도 3c는 마무리된 센서 어셈블리에 대해 요구되는 원하는 두께와 실질적으로 등가의 두께를 이미 갖는 박막 반도체 박판을 활용하여 BSI 센서가 제조되는 본 개시의 실시예의 단면도들을 도시한다. 박판은 1 내지 20미크론(μm) 또는 1 내지 10 μm 두께와 같이 50 μm 두께 미만일 수 있다. 제공된 박판의 두께는 예를 들어, BSI 센서의 제조를 위한 프로세싱 단계들 동안 그의 초기 제공된 두께의 적어도 80% 내에서 실질적으로 변경되지 않은 채로 유지된다.

- [0015] [0019] 도 3a에서, 박막 반도체 박판(360)이 제공되며, 여기서 반도체 박판(360)은 전면 표면(362), 배면 표면(364) 및 제 1 전도성을 갖는다. 박판(360)은 전면 표면(362) 및 배면 표면(364) 간에 측정된 두께를 갖는다. 반도체 박판(360)은 박막의 핸들링을 돕기 위해 배면 표면(364)에서 임시 지지부(380)에 의해 접촉될 수 있다. 임시 지지부(380)는 진공, 정전기 또는 화학력과 같이 임의의 타입의 분리 가능한 힘 또는 접촉에 의해 박판(360)에 접촉될 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 반도체 박판(360)은 도핑된 n-타입 또는 p-타입 단결정질 실리콘일 수 있다. 도핑 농도는 예를 들어, 약 1×10^{15} 내지 약 1×10^{18} 도펀트 atoms/cm³ 또는 예를 들어, 약 1×10^{17} 도펀트 atoms/cm³일 수 있다. 하나 이상의 도핑된 영역들(350)이 전면 표면(362)에서 반도체 박판(360) 내에 형성되며, 여기서 도핑된 영역들(350)은 반도체의 전도성과 상이한 전도성을 갖는다. 본 발명의 일 양상은 50 μ m 두께 미만과 같이 임의의 두께의 임의의 박판 상에 형성될 수 있다는 것이다. 본 발명의 다른 양상은 박리 프로세스에 의해 생성될 수 있는 박판의 결함이 도핑된 다이오드 영역들의 제조 이전에 수선(repair)될 수 있다는 것이다.
- [0016] [0020] 도 3a의 도핑된 영역들(350)은 확산 도핑을 포함해서 당 분야에 알려진 방법들에 의해 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 3a에서 도시된 바와 같이, 도핑된 유리층(390)이 대기압 PCVD(atmospheric pressure chemical vapor deposition)와 같은 임의의 방법에 의해 전면 표면(362) 상에 형성될 수 있다. p-타입 도펀트에 대해, 도핑된 유리층(390)은 예를 들어, 붕소로 도핑된 BSC(horosilicaie glass)일 수 있다. 소스 가스는 붕소 예를 들어, BBr₃, B₂H₆, 또는 BCl₃를 제공할 임의의 적합한 가스일 수 있다. n-타입 도펀트에 대해, POCl₃와 같은 적절한 가스가 전면 표면(362) 상에 약 30분 동안 약 880℃에서 유동되어, PSG(phosphosiicate glass)를 형성할 수 있다. 다른 실시예들에서, 도펀트-제공 물질은 전면 표면(362) 상에서 회전(spun)되고 베이킹(bake)될 수 있다. 또 다른 실시예들에서, 도핑된 유리는 BN과 같은 고체 소스 상에 O₂를 유동시킴으로써 열적으로 성장될 수 있다. 도핑된 유리층(390)은 예를 들어, 약 500 내지 약 1500 옹스트롬, 예를 들어, 약 1000 옹스트롬의 두께를 가질 수 있다. 다음으로, 도핑된 유리(390)는 예를 들어, 스크린 프린팅 에천트 페이스트(screen printing etchant paste)에 의해 선택된 영역들에서 제거되어, 도핑된 영역들(350)이 형성되는 유리 영역들(392)(음영진 영역들로 도시됨)을 남긴다. 대안적으로, 도핑된 영역들(350)은 n-타입 도펀트를 포함하는 비정질 실리콘의 증착에 의해 전면 표면(362) 상에 형성될 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 비정질 실리콘의 고유(도핑되지 않은)층은 도핑된 비정질 실리콘층과 전면 표면(362) 간에 개재될 수 있다.
- [0017] [0021] 도핑된 영역(350)을 형성하기 위한 대안적인 프로세스에서, Si₃N₄(도시되지 않음)가 전면 표면(362) 상에 증착될 수 있다. 스크린 프린트 에천트 페이스트는 도핑된 영역들(350)이 형성되지 않는 전면 표면(362) 상의 임의의 위치들을 마스크하도록 Si₃N₄를 에칭하기 위해 적용된다. 대안적으로, 종래의 포토리소그라피 기법들이 이들 마스크된 영역들을 정의하는데 이용될 수 있다. 인(예를 들어, POCl₃)의 소스를 이용하는 확산 도핑이 n-타입 도핑된 영역들을 형성하도록 수행되어, 붕소-함유 대기(예를 들어, BBr₃)가 노출된 영역들에서 p-타입 영역들을 형성하도록 이용된다. 임의의 잔여 Si₃N₄는 HF(hydrofluoric acid)와 같이 알려진 방법들을 이용하여 그 시간에 에칭될 수 있다. 얇은 산화물 층이 웨이퍼 상에서 성장될 수 있다.
- [0018] [0022] 예를 들어, 약 850 내지 약 1000℃의 어닐링이 약 30분 내지 약 90분 동안 노(furnace)에서 수행되고, 전면 표면(362)에서 유리 영역(392)으로부터 반도체 박판(360)으로 도펀트들을 확산한다. 확산은 도핑된 P-타입(예를 들어, BSG로부터) 또는 n-타입(예를 들어, PSG로부터) 영역들(350) 중 어느 하나를 형성한다. 다음으로, 종래의 습식 에칭, 예를 들어, HF 딥(dip)은 전면 표면(362)에서 노출된 도핑된 영역들(350)을 남기도록 BSG 또는 PSG를 제거한다. 붕소 및 인은 각각 가장 흔히 이용되는 p-타입 및 n-타입 도펀트들이지만, 다른 도펀트들이 이용될 수 있다.
- [0019] [0023] 도핑된 영역들(350)이 박막 반도체 박판(360)에 형성된 이후, 전기 연결들이 도 3b에서 도시된 바와 같이 형성될 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 전기 연결은 금속화층(340)에서 하나 이상의 서브-층들을 포함할 수 있다. 금속화층들(340)은 예를 들어, 물리적 기상 증착을 이용한 스퍼터 증착에 의해 형성될 수 있다. 금속화층들(340)은 예를 들어, 티타늄, 티타늄-텅스텐, 또는 구리를 포함할 수 있다. 당 분야에 알려진 포토리소그라피 방법들이 도 3c에서 도시된 바와 같이 도핑된 영역들(350)로의 전기 연결들(342)을 형성하기 위해 금속화층들(340)에서 원하는 배선 패턴들을 마스크 및 에칭하는데 이용될 수 있다. 후속 제조 단계들은 이어서 박막 반도체 박판(360)으로부터 배면측-조명 센서를 제조하기 위해 실행될 수 있다. 예를 들어, 구리-주석, 구리-인듐 또는 인듐-주석 범프들(344)은 집적 회로(330)의 본딩을 용이하게 하기 위해 금속화층들(340) 상에 전기도금될

수 있다. 이 본당은 구리 및 주석 또는 인듐 및 인듐 또는 인듐 및 주석을 이용하여, 집적 회로와 박판 간의 전기 연결들을 발생시킬 수 있는 임의의 알려진 방법, 예를 들어, 구리-구리 열-압축 본당, 또는 고체-액체 인터-확산 본당을 이용하여 달성될 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 집적 회로(330)는 CMOS(complementary metal-oxide semiconductor)일 수 있다.

[0020] [0024] 원하는 컴포넌트들이 박막 반도체(360)의 전면 표면(362) 상에 구성된 이후, 임시 지지부(380)가 박판(360)의 배면 표면(364)으로부터 제거된다. 완성된 BSI 센서는 예를 들어, 코팅들, 컬러 필터들 및 마이크로-렌즈들을 배면 표면(364)에 부가함으로써 제조될 수 있다(예를 들어, 도 2). 도 3a 내지 도 3c의 실시예들에서 알 수 있는 바와 같이, 초기 제공된 박막 반도체 박판(360)의 두께는 배면측 조명 센서의 제조 동안 실질적으로 변경되지 않은 채로 유지되며, 이에 따라 그린딩에 의해 생성되는 이슈를 감소시킨다.

[0021] [0025] 도 4의 흐름도(400)는 도 3a 내지 도 3c의 실시예들을 예시한다. 흐름도(400)의 예시적인 방법은 단계(410)에서 박막 반도체 박판을 제공하는 것으로 시작한다. 단계(420)에서, 임시 캐리어 또는 지지부가 프로세싱 동안 취약한 박판의 핸들링을 지원하기 위해 박판의 배면 표면에 대해 접촉될 수 있다. 하나 이상의 도핑된 영역들은 단계(430)에서 박판의 전면 표면에 형성되며, 여기서 도핑된 영역들이 박막 반도체의 전도성과 반대의 전도성을 갖는다. 단계(440)에서, 하나 이상의 전기 연결들이 도핑된 영역에 대해 형성된다. 전기 연결들은 예를 들어, 금속화층들, 솔더 범프들 및 열-압축 인터페이스들을 포함할 수 있다. 임시 캐리어가 단계(450)에서 제거되며, 그 이후 마무리된 배면측-조명 센서는 원할 때 박판의 배면 표면 상에서 임의의 부가적인 제조 단계들을 수행함으로써 단계(460)에서 제조될 수 있다. 이들 마무리하는 단계들은 예를 들어, 코팅들, 컬러 필터들 및 마이크로-렌즈들을 부가하는 것을 포함할 수 있다. 코팅들은 박판의 배면 표면을 패시베이션(passivate)하는 층들을 포함할 수 있다. 이들 패시베이션 층들은 450°C 미만의 온도에서 플라즈마-강화된 화학 기상 증착에 의해 증착되는 수소화된 비정질 실리콘의 10Å 내지 300Å 층을 포함할 수 있다. 마무리하는 단계들은 클리빙 주입 프로세스(cleaving implant process) 동안 초래되는 손상을 제거하기 위해 박판의 배면 표면으로부터 일부 물질을 에칭하는 것을 또한 포함할 수 있다.

[0022] [0026] 본 개시의 다른 실시예는 도 5a 내지 도 5c에서 도시된다. 이 실시예에서, 도 5a의 도핑된 영역들(550)은 반도체 도너 바디(500)에 형성되고, 이어서 박판이 반도체 도너 바디(500)로부터 클리빙되며, 여기서 박판은 도핑된 영역들(550)을 포함한다. 도너 바디(500)는 임의의 실제 두께 예를 들어, 약 200 내지 약 1000 미크론 두께의 단결정질 실리콘 웨이퍼와 같은 적절한 반도체 물질이다. 대안적인 실시예들에서, 도너 웨이퍼는 더 두꺼울 수 있고; 최대 두께는 웨이퍼 핸들링의 실용성들(practicalities)에 의해서만 제한된다. 대안적으로, GaAs, InP 등과 같이 게르마늄, 실리콘 게르마늄, 또는 III-V 또는 II-VI 반도체 화합물들을 포함하는 다른 반도체 물질의 웨이퍼들 또는 잉곳(ingot)들이 이용될 수 있다.

[0023] [0027] 단결정질 실리콘을 형성하는 프로세스는 일반적으로 원형 웨이퍼를 발생시키지만, 도너 바디는 다른 형상들을 또한 가질 수 있다. 실린더형 단결정질 잉곳들은 종종 웨이퍼들을 절단하기 이전에 8각 단면으로 머시닝된다. 다결정질 웨이퍼들은 종종 직사각형이다. 직사각형 웨이퍼들은 원형 또는 6각형 웨이퍼들과 달리, 이들이 그들 간에 최소의 미사용 갭들을 갖도록 에지-대-에지로 정렬될 수 있다는 이점을 갖는다. 웨이퍼의 직경 또는 폭은 임의의 표준 또는 관습적인 크기일 수 있다. 단순함을 위해, 본 개시는 반도체 도너 바디로서 단결정질 실리콘 웨이퍼의 이용을 설명하지만, 다른 타입들 및 물질들의 도너 바디들이 이용될 수 있다는 것이 이해될 것이다.

[0024] [0028] 도핑된 영역들(550)을 포함하는 박판의 박리는 이온 유도 클리비지 반응(ion induced cleavage reaction)을 포함하는 임의의 조치에 의해 발생할 수 있다. Sivaram 등에 의해 2008년 2월 5일 출원되고, 본 발명의 양수인에 의해 소유되며, 그에 의해 인용에 의해 포함되는, 발명의 명칭이 "Method to Form a Photovoltaic Cell Comprising a Thin Lamina"인 미국 특허 출원 번호 제12/026530호는 가스 이온들 예를 들어, 수소 및/또는 헬륨 이온들의 하나 이상의 종들로 주입되는 (도핑 영역들(550) 없는) 반도체 도너 웨이퍼를 설명한다. 주입된 이온들은 반도체 도너 웨이퍼(500) 내에서 도 5a의 클리브 플레인(501)과 같은 클리브 플레인을 정의한다. 본 개시에서 도너 바디로서 또한 지칭되는 반도체 도너 웨이퍼(500)는 추후에-박리되는 박판의 전면 표면(562)이 되는 제 1 표면(562)을 갖는다. 가스 이온들은 클리브 플레인(501)을 생성하도록 제 1 표면(562)을 통해 (화살표(503)에 의해 표시된 바와 같이) 주입된다. 이 수소 또는 헬륨 주입의 비용은 Parrill 등에 의해 2008년 5월 16일 출원되고, 발명의 명칭이 "Ion Implanter for Photovoltaic Cell Fabrication"이며, 본 발명의 양수인에 의해 소유되고 그에 의해 인용에 의해 포함되는, 미국 특허 출원 번호 제12/122108호에서 설명된 방법들에 의해 감소될 수 있다. 제 1 표면(562)으로부터 측정된 바와 같은 클리브 플레인(501)의 전체 깊이는 주입 에너지를 포함하는 몇 개의 팩터들에 의해 결정된다. 클리브 플레인(501)의

깊이는 제 1 표면(562)으로부터 약 0.2 내지 약 100 μm , 예를 들어, 약 0.5 내지 약 20 μm ; 또는 약 0.5 내지 약 50 μm , 예를 들어, 약 1 내지 약 25 μm , 또는 약 8 미크론 내지 약 20 μm 일 수 있다. 클리브 플레인(501)의 깊이는 클리빙된 박판의 두께를 결정할 것이다. 바람직하게는, 클리빙된 박판의 두께는 완성된 BSI 센서에서 반도체 기관의 원하는 두께와 실질적으로 등가가 되도록 선택된다. 따라서 본 발명의 실시예들에 따라 BSI에 대한 반도체 기관은 유리하게는 두께면에서 매우 정밀한 균일도를 갖고 특히 원하는 두께를 갖도록 생성될 수 있다.

[0025] [0029] 도 5b에서 도시된 바와 같이, 어닐링 반응은 박판(560)이 클리브 플레인(501)에서 도너 웨이퍼(500)로부터 클리빙하게 하며, 여기서 클리브 플레인(501)은 박판(560)의 배면 표면(564)을 생성한다. 반도체 도너 바디(500)의 제 1 표면(562)은 박판(560)의 전면 표면(562)이 된다. 도너 웨이퍼(500)는 제 1 표면(562)에서 반도체 도너 바디(500)로부터 박판(560)을 리프트하는데 이용될 수 있는 임시 지지부 엘리먼트(585)에 부착된다.

[0026] [0030] Sivaram 등의 실시예들에 따라, 반도체 박판(560)은 약 0.2 내지 약 100 μm 두께, 예를 들어, 약 0.2 내지 약 50 μm , 예를 들어, 약 1 내지 약 25 μm 두께, 몇몇 실시예들에서, 약 5 내지 약 20 μm 두께일 수 있지만, 지명된 범위 내의 임의의 두께도 가능하다. Sivaram 등의 방법들을 이용하면, 광전지 셀들은 불필요하게 두꺼운 셀의 제조에 의해 또는 과도한 커프 손실(excessive kerf loss)을 통해 실리콘을 낭비함 없이, 슬라이싱된 웨이퍼로부터 형성되는 것보다 오히려 얇은 반도체 박판으로 형성되고, 이에 따라 비용을 감소시킨다. 동일한 도너 웨이퍼는 비용을 추가로 감소시키도록 다수의 박판을 형성하기 위해 재사용될 수 있고, 몇몇 다른 이용을 위해 다수의 박판의 박리 이후에 재판매될 수 있다.

[0027] [0031] 그렇지만, Sivaram 등의 방법들에서, 웨이퍼는 얇은 박판에 대한 기계적 지지부를 제공하기 위해 프로세스에서 앞서 임시 또는 영구 지지부 엘리먼트에 접촉되어야 한다. 통상적으로, 이러한 방식으로 형성된 박판은 지지부 엘리먼트를 제거하기 위해 분리 단계에 참여하거나 임의의 결과적인 디바이스에 지지부 엘리먼트를 통합해야 한다. 본 개시의 몇몇 실시예들에서, 얇은 프리-스탠딩 박판이 형성되고 지지부 엘리먼트에 대한 영구적 본딩 또는 접착 없이 그리고 박판으로부터 디바이스를 제조하기 이전의 분리 또는 세척 단계들을 요구함 없이 도너 바디로부터 분리될 수 있어서, 박판의 전면 또는 배면 표면에 대한 임의의 수의 프로세싱 단계들을 유익하게 제공한다. 도너 바디(500)의 제 1 표면(박리된 박판의 전면 표면일 것임)은 지지부 엘리먼트(585)에 인접하게 배치되고, 표면이 프로세싱 단계들로 처리되기 이전에 또는 이후에 도너 바디의 제 1 표면으로부터 박판을 박리하는 어닐링 단계가 수행될 수 있다. 클리빙된 플레인(501)은 박판의 배면 표면을 생성하고, 재차 다시 한번, 임의의 수의 프로세싱 단계들이 이어서 박리된 박판의 어느 한 측 상에서 발생할 수 있다. 이들 프로세스들은 Kell 등에 의해, 2011년 12월 20일 출원되고, 그에 의해 인용에 의해 포함되는, 발명의 명칭이 "A Method and Apparatus for Forming a Thin Lamina"인 미국 특허 출원 번호 제13/331,909호에서 설명된 바와 같이 박판 상에 본딩된 지지부 엘리먼트 없이 발생할 수 있다.

[0028] [0032] 도 5c로 넘어가서, 박리 이전에, 본 발명의 반도체 도너 바디(500)의 제 2 표면(502)은 서셉터 어셈블리와 같은 임시 지지부 엘리먼트(586)에 분리 가능하게 접촉될 수 있다. 도너 바디(500)와 지지부 엘리먼트(586) 간의 접촉은 진공, 정전기 또는 화학력과 같이 임의의 타입의 분리 가능한 힘 또는 접착을 포함할 수 있다. 몇몇 실시예들에서, 박판의 박리 동안 도너 바디(500)와 서셉터(586) 간의 상호작용 힘은 단지 서셉터(586) 상의 도너 바디(500)의 무게이다. 박리 장비가 도 5b에서 도시된 것으로부터 수직으로 인버팅되는 구성을 갖는 다른 실시예들에서, 상호작용 힘은 단지 도너 바디 상의 서셉터 어셈블리(586)의 무게이다. 도너 바디(500)와 서셉터 어셈블리(586)의 접촉에 이어, 열 또는 다른 힘이 클리브 플레인(501)에서 도너 바디(500)로부터 박판(560)을 클리빙하도록 도너 바디(500)에 인가될 수 있다. 박리 조건들은 영구적으로 부착되는 지지부 엘리먼트 없이, 박리되는 박판에서 물리적 결합들을 최소화하기 위해 도너 바디로부터 박판을 클리빙하도록 최적화될 수 있다. 박리는 예를 들어, 약 350 내지 약 650 $^{\circ}\text{C}$ 의 온도들에서 수행될 수 있다. 일반적으로 박리는 더 높은 온도에서 더 빨리 진행된다.

[0029] [0033] 클리브 플레인(501)에서 도너 웨이퍼(500)로부터 박판(560)을 클리빙하는데 있어서, 박판(560)의 전면 표면(562)에 대향하는 배면 표면(564)은 도 5c에서 도시된 바와 같이 생성된다. 도핑된 영역들(550)은 박판(560) 내에 그리고 전면 표면(562)에 위치된다. 박판(560)은 이온 주입에 의해 야기되는 임의의 손상을 제거하기 위해 어닐링될 수 있다. 프리-스탠딩 박판(560)은 임시 지지부 엘리먼트에 전면 표면(562) 또는 배면 표면(564) 중 어느 하나에서 임시로 접촉될 수 있다. 예를 들어, 도 5c의 지지부 엘리먼트(580)는 추가의 제조 단계들 동안 배면 표면(564)에 다시 접촉하고, 위의 도 3b 내지 도 3c에 관해 설명된 바와 같이 박판(560)을 배면 측-조명 센서로 제조하기 위해 추후에 제거된다.

[0030] [0034] 이온들을 주입하고, 반도체 도너 바디를 클리빙하고 도핑된 영역들을 형성하는 단계들은 450 $^{\circ}\text{C}$ 초과와

같은 높은 온도들에서 발생한다는 것에 주의한다. BSI 센서를 제조하는 앞선 스테이지들에서 이런 높은 온도 단계들을 수행하는 것은 유리하게는 보다 열적으로 약한 물질들이 배면측-조명 센서를 제조하는 추후의 단계들에서 이용되도록 허용한다. 본 발명의 몇몇 실시예들에서, 완성된 BSI 센서의 제조 동안, 이온들을 주입하고, 반도체 도너 바디를 클리빙하고 도핑된 영역을 형성하는 단계들만이 약 450℃ 초과와 프로세싱 온도들을 갖는다. 다른 실시예들에서, 도핑 영역을 형성하는 것은 이온들을 주입하는 단계 이전에 발생한다.

[0031] [0035] 도 6의 흐름도(600)는 도 5a 내지 도 5c의 방법들의 예시적인 실시예를 예시한다. 단계(610)에서, 반도체 도너 바디가 제공된다. 마무리된 BSI 센서 어셈블리의 광다이오드로서 역할하게 되는 하나 이상의 도핑된 영역들이 단계(620)에서 도너 바디에 형성된다. 도핑된 영역들은 도너 바디의 제 1 표면에 형성되고 도너 바디의 전도성과 상이한 전도성을 가진다. 이온들이 단계(630)에서 클리브 플레인을 형성하도록 반도체 도너 바디 내로 주입되고 이어서 반도체 박판이 단계(640)에서 도너 바디로부터 클리빙된다. 반도체 바디의 제 1 표면은 박판의 제 1 표면으로서 역할하고, 클리브 플레인은 박판의 배면 표면을 생성한다. 또한, 도핑된 영역들은 박판의 전면 표면에 포함된다. 단계(650)에서, 임시 캐리어 또는 지지부는 반도체 박판의 배면 표면에 접촉된다. 위에서 설명된 금속화층들과 같은 전기 연결들이 단계(660)에서 박판의 전면측 상의 도핑된 영역들에 커플링된다. 임시 캐리어가 단계(670)에서 제거된다. 마무리된 배면측-조명 센서는 도 4의 단계(460)에 관해 설명된 것들과 같이 박판의 배면 표면 상에 요구되는 임의의 부가적인 제조 단계들을 수행함으로써 단계(680)에서 제조될 수 있다.

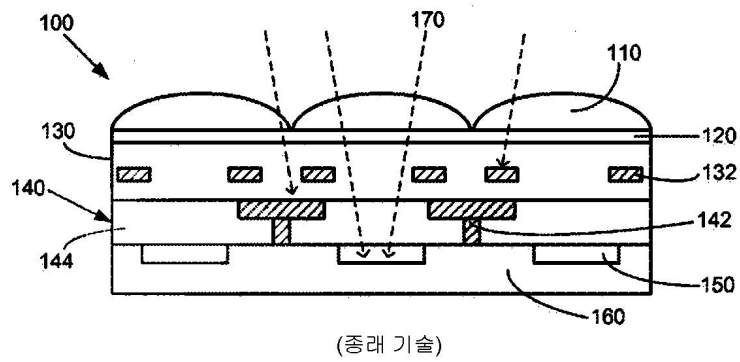
[0032] [0036] 위에서 논의된 바와 같이, 본 발명의 실시예들은 BSI 센서에 대한 원하는 두께를 달성하기 위해 추가의 박화를 요구하지 않는 박판을 제공하고, 이에 따라 비용을 감소시키고 제조성을 개선하는 방법을 제공한다. 제공된 박판의 두께는 실질적으로 변경되지 않은 채로 유지되는데, 이를 테면, 예를 들어, 에칭 - 박판의 프로세싱 및 배면측-조명 센서의 제조 동안 - 의 결과로서 기껏해야 그의 초기 두께의 20%까지 변형된다. 방법들의 실시예들은 또한 제조 프로세스에서 앞서 다이오드 영역들을 도핑- 통상적으로 높은 온도를 요구하는 프로세스들-하는 것을 포함하며, 결과적으로 후속 제조 단계들에서 더 낮은 온도 물질들 및 프로세스들의 이용을 허용한다.

[0033] [0037] 부가적인 단계들이 본 발명의 범위로부터 벗어남 없이 본 개시에서 설명되는 흐름도에 포함될 수 있다는 것이 주의된다. 예를 들어, 몇몇 실시예들에서, 임시 지지부는 전면 표면에 또한 접촉될 수 있다. 유사하게, 전면 및 배면 표면들 중 어느 하나 또는 둘 다에 접촉하는 임시 지지부들은 마무리된 BSI 센서 어셈블리의 제조에 수반되는 다양한 단계들을 통해 박판을 전달하는데 이용될 수 있다. 다른 실시예들에서, 에칭 또는 다른 표면 준비 프로세스들이 수행될 수 있다. 에칭 단계는 박판의 배면 표면에서 손상을 제거하도록 역할할 수 있다. 이 에칭 단계는 예를 들어, 습식 또는 플라즈마 처리에 의해 수행될 수 있다. 플라즈마 처리는 예를 들어, SF₆ 대기에서 발생할 수 있다. 에칭된 양은 총 박판 두께의 20% 미만일 수 있다.

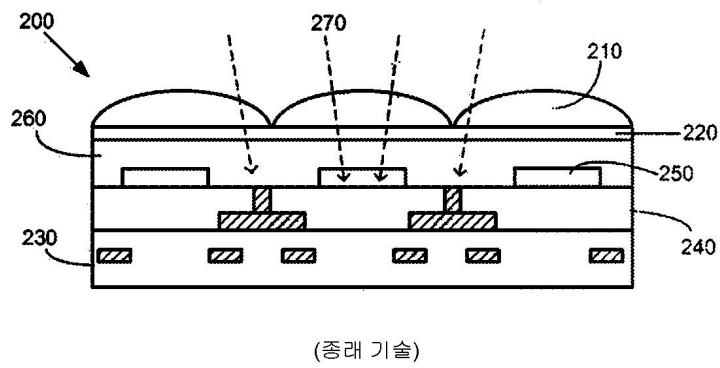
[0034] [0038] 본 명세서가 본 발명의 특정한 실시예들에 관해 상세히 설명하였지만, 당업자들은, 위의 내용을 이해하면, 이들 실시예들에 대한 변경들, 그의 변동물들, 및 그의 등가물들을 쉽게 생각해낼 수 있다는 것이 인지될 것이다. 본 발명에 대한 이들 및 다른 변형들 및 변동물들은, 특히 첨부된 청구항들에서 제시되는 본 발명의 사상 및 범위로부터 벗어남 없이 당업자들에 의해 실시될 수 있다. 또한, 당업자들은 위의 설명은 단지 예이며 본 발명을 제한하는 것으로 의도되지 않는다는 것을 인지할 것이다.

도면

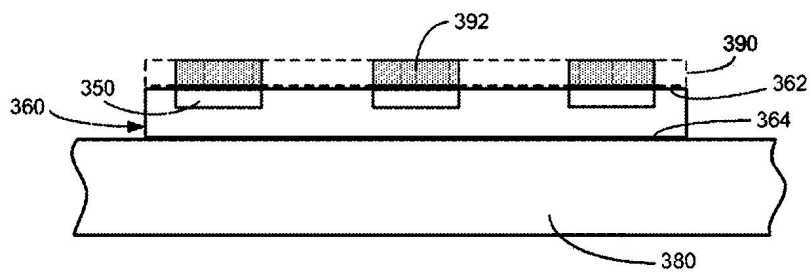
도면1



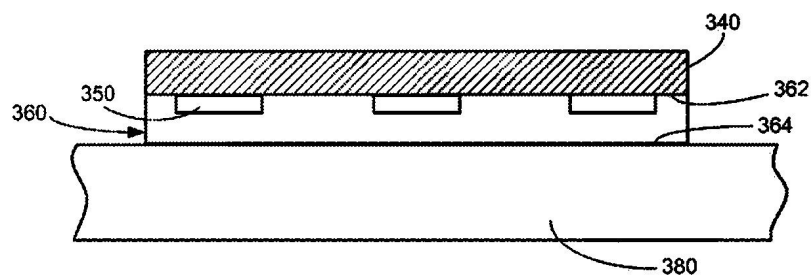
도면2



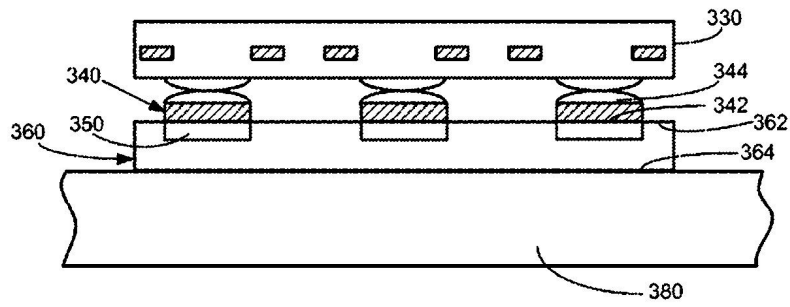
도면3a



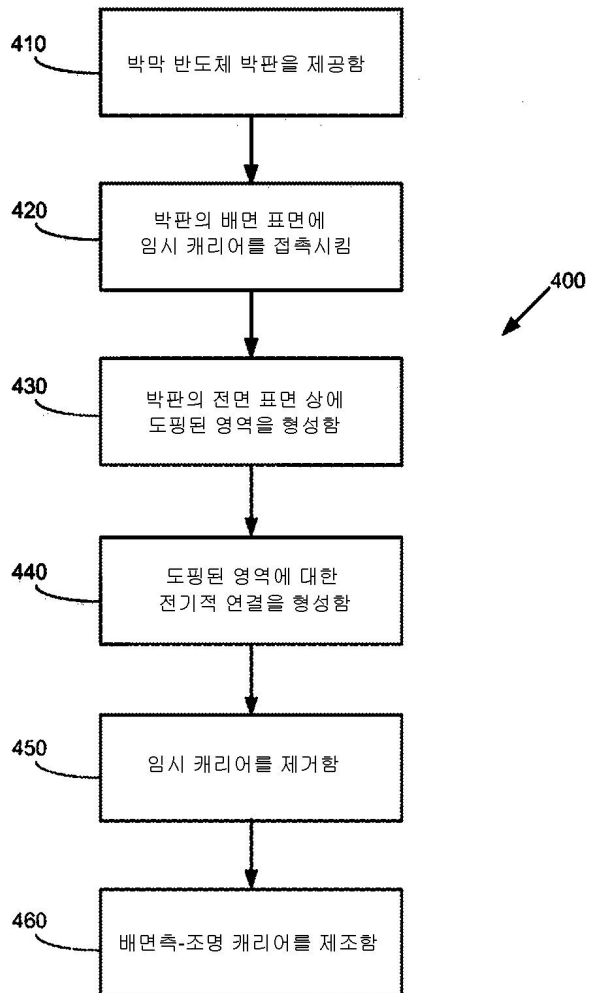
도면3b



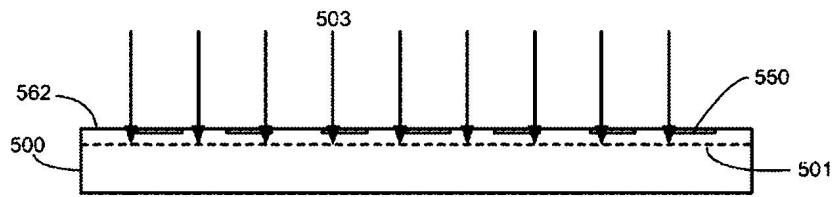
도면3c



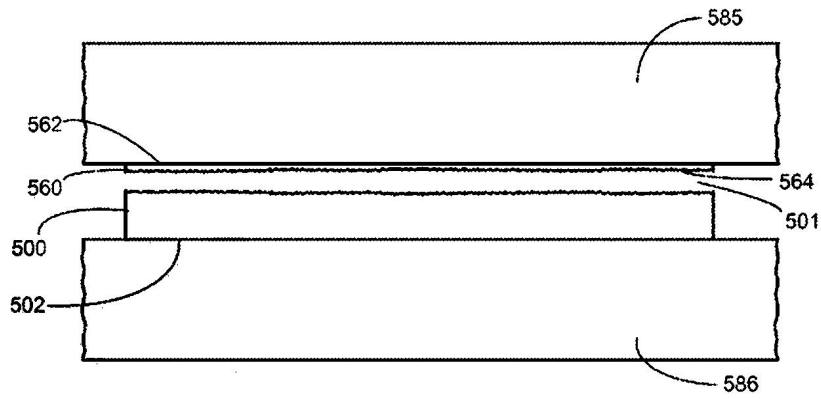
도면4



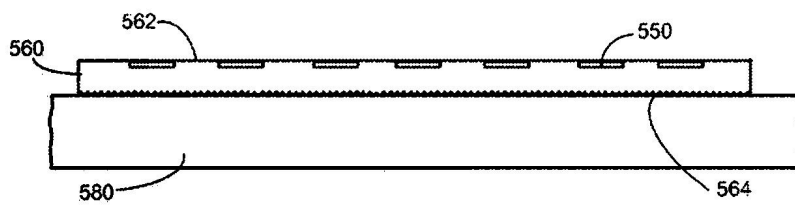
도면5a



도면5b



도면5c



도면6

